

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-186117

(43)公開日 平成8年(1996)7月16日

(51)Int.Cl.⁶
H 01 L 21/321
21/60

識別記号 301 G
311 Q

9169-4M
9169-4M

F I

H 01 L 21/ 92 604 K
602 R

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全9頁)

技術表示箇所

(21)出願番号

特願平6-327955

(22)出願日

平成6年(1994)12月28日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社
大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 小野 正浩

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 別所 芳宏

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 戸村 善広

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

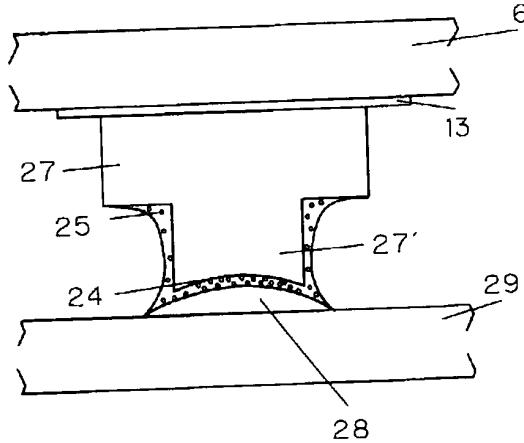
(74)代理人 弁理士 小鍛治 明 (外2名)

(54)【発明の名称】 ワイヤボンディング装置用キャビラリーとパンプの形成方法

(57)【要約】

【目的】 半導体装置をスクリーン印刷やメッキ等によって形成された回路基板の端子電極上へ、接合層を介してフェイスダウン実装する際に、半導体装置のパンプの先端部と回路基板の端子電極とを信頼性よく電気的に接続する。

【構成】 半導体装置6のパンプの先端部に湾曲面24が形成されており、接合層を介して回路基板29の入出力端子電極28にフェイスダウン実装されている。このことによって、接合層の厚みを最も薄く均一なものにでき、接続部の接続抵抗が低く、信頼性の高い電気的接続と接着を実現できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体装置の電極パッド上にバンプを形成するためのボールボンディング用のキャビラリーであって、前記キャビラリーは、金属ワイヤのボール状の先端部を電極パッドに対して押圧し、前記ボール状先端部を前記電極パッドに圧着させる押圧部材と、前記押圧部材に設けられた、前記金属ワイヤを供給する導出孔と、前記電極パッド上に形成されたバンプの先端部に凹型状に湾曲した面を設けるためのレベリング部材とを備えたワイヤボンディング装置用のキャビラリー。

【請求項2】押圧部材は、キャビラリーの下端面（第1の下端面）を含んでおり、レベリング部材は、バンプを押圧する第2の下端面を有し、前記第2の下端面が凸状の湾曲面を有している請求項1に記載のワイヤボンディング装置用のキャビラリー。

【請求項3】回路基板の表面の端子電極と、前記回路基板の表面上にフェイスダウン状態で実装される半導体装置の電極パッドとを電気的に接続するためのバンプであって、前記半導体装置の電極パッド上に形成された、先端部に凹型状に湾曲した面を有するバンプ。

【請求項4】ワイヤボンディング装置を用いて、回路基板の表面の端子電極と、前記回路基板の表面上にフェイスダウン状態で実装される半導体装置の電極パッドとを電気的に接続するためのバンプを形成する方法であって、前記バンプを前記半導体装置の電極パッド上に形成する工程aと、金属ワイヤを切除すると同時に、前記バンプの先端部に凹型状に湾曲面を形成する工程bとを含むことを特徴とする湾曲面を有するバンプの形成方法。

【請求項5】工程bは、バンプの先端部形状を揃えるために前記バンプをレベリングする工程を含むことを特徴とする請求項4記載の湾曲面を有するバンプの形成方法。

【請求項6】バンプは、Au, Cu, Al, 半田またはこれらのいずれかを含む合金から形成されていることを特徴とする請求項4記載の湾曲面を有するバンプの形成方法。

【請求項7】工程aは、ボールボンディング法によってバンプを電極パッド上に形成することを特徴とする請求項4記載の湾曲面を有するバンプの形成方法。

【請求項8】回路基板の表面の端子電極と、前記回路基板の表面上にフェイスダウン状態で実装される半導体装置の電極パッドとを電気的に接続するためのバンプを形成する方法であって、前記バンプを前記半導体装置の電極パッド上に形成する工程と、前記バンプの先端部に凹型状の湾曲面を凸型状の湾曲面をもつ治具を用いて形成する工程からなることを特徴とする湾曲面を有するバンプの形成方法。

【請求項9】バンプは、メッキ法、ワイヤボンディング法などによって電極パッド上に形成されることを特徴とする請求項8記載の湾曲面を有するバンプの形成方法。

【請求項10】表面に端子電極を有する回路基板と、前記回路基板の表面上にフェイスダウン状態で実装された半導体装置とを有する半導体ユニットであって、前記半導体装置は、電極パッドと、前記電極パッドと前記端子電極とを電気的に接続するためのバンプとを有し、前記バンプの先端部に湾曲面が形成され、前記バンプの先端部と前記端子電極との間に接合層が形成されていることを特徴とする半導体ユニット。

【請求項11】接合層は、導電性接着剤から形成されることを特徴とする請求項10記載の半導体ユニット。

【請求項12】接合層は、異方性導電材から形成されることを特徴とする請求項10記載の半導体ユニット。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、ワイヤボンディング装置用のキャビラリー、それを用いることによる、回路基板の端子電極と半導体チップの電極パッドとを電気的に接続するための湾曲面を有するバンプおよびバンプの形成方法およびそのバンプを用いた半導体ユニットに関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来のワイヤボンディング装置用のキャビラリーは、マイクロスイス社のボンディングハンドブックやキャビラリーカタログなどに記載されている。

【0003】図10(a)はワイヤボンディング装置用のキャビラリーの先端部を示し、図10(b)はキャビラリーの先端部の形状をより詳細に示している。

【0004】図10(a)に示されるように、円筒形のキャビラリー81は、内部にボンディング用の金属ワイヤを挿入するためのワイヤ導出孔82を有している。ワイヤ導出孔82の大きさは、 $25\mu\text{m}\phi$ ～ $50\mu\text{m}\phi$ 程度である。キャビラリー81の先端部の外側には、ボンディングする間隔とボンディング後の金属ワイヤの形状および大きさとを考慮し、 30° 程度の角度 α がつけられている。

【0005】 $25\mu\text{m}\phi$ 程度の金属ワイヤを用いる場合のキャビラリー81の先端部の形状が図10(b)に示されている。この場合、ホール径： $38\mu\text{m}$ 、チップ径： $203\mu\text{m}$ 、およびチャンファー径： $74\mu\text{m}$ である。このようなキャビラリー81を用いることによって半導体装置の電極パッド上にバンプを形成したり、他の回路基板の端子電極への電気的な接続を行うことができる。

【0006】次に、ワイヤボンディング用のキャビラリーを用いて、ボールボンディング法によって半導体装置のバンプを形成する従来の方法を説明する。特開平2-34949号公報には、2段突出形状の電気的接続バンプ（以下2段バンプという）と、従来のキャビラリーを用いた2段バンプの形成方法が示されている。

【0007】図11(a)～(d)は、従来のボールボ

ンディング法によって、2段バンプを形成する方法を示している。

【0008】図11(a)に示すように、キャピラリー81のワイヤ導出孔82に25μmの金属ワイヤ84を通す。そして、金属ワイヤ84の先端に、熱エネルギーを与えることにより、金属ワイヤ84の径の約2~3倍の径を有するボール85を形成する。

【0009】次に、図11(b)に示すように、キャピラリー81を降下させることにより、金属ワイヤ84の先端に形成されたボール85を、ICチップ86の電極パッド183に当接させる。熱圧着の方法や超音波振動を与えることによってボール85を電極パッド183に固着させ、2段バンプの底部89を形成する。

【0010】そして、図11(c)に示すように、2段バンプの底部89と、キャピラリー81のワイヤ導出孔82に通された金属ワイヤ84とがつながった状態のまま、キャピラリー81をICチップ86に対してループ状に移動させる。キャピラリー81は、まず、2段バンプの底部89上方に垂直に上昇してからループ状軌道を描くように移動し、その後、垂直に降下しながら、金属ワイヤ84を切断する。

【0011】図11(d)に示されるように、キャピラリー81のループ状の運動により、底部89の上には金属ワイヤ84がリング状または逆U字状に形成される。この部分が2段バンプの頂部88を形成する。キャピラリー81のエッジ部分182によって金属ワイヤ84が切断されることにより、2段バンプが形成される。

【0012】この2段バンプをレベリングした(高さを揃えた)ものの概略断面図を図12に示す。

【0013】それから、実装方法の従来例について以下に述べる。従来、回路基板の入出力端子電極に半導体装置を実装する際には、半田付けを用いたワイヤボンディング方法がよく利用されてきた。しかし、近年、半導体装置のパッケージの小型化と接続端子数の増加により、接続端子の間隔が狭くなり、従来の半田付け技術で対処することが次第に困難になってきた。

【0014】そこで、最近では集積回路チップ等の半導体装置を回路基板の入出力端子電極上に直接実装することにより、実装面積を小型化して効率的使用を図ろうとする方法が提案してきた。

【0015】なかでも、半導体装置を回路基板にフェイスダウン状態でフリップチップ実装する方法は、半導体装置と回路基板との電気的接続が一括してできること、および接続後の機械的強度が強いことから有用な方法であるとされている。

【0016】例えば、工業調査会、1980年1月15日発行、日本マイクロエレクトロニクス協会編、「IC化実装技術」には、半田めっき法を用いた実装方法が記載されている。この実装方法を以下に説明する。

【0017】図13は従来の半導体装置の半田バンプの

概略断面図(a)および半導体ユニットの概略断面図(b)を示す。図13に示されるように、半導体装置(IC基板)116の電極パッド113を図(b)に示す回路基板119の入出力端子電極118に接続する場合に、まず半導体装置(IC基板)116の電極パッド113上に密着金属膜112および拡散防止金属膜111を蒸着法によって形成し、さらに、この上に半田からなる電気的接続接点(以下、半田バンプという)110をメッキ法により形成する。次に、このようにして形成されたICチップを、図13(b)に示されるようにフェイスダウン状態で、半田バンプ110が入出力端子電極118上に当接するように位置合わせを行い、回路基板119上に載置する。その後、この半導体装置の実装体(半導体ユニット)を高温に加熱することにより、半田バンプ110を回路基板119の入出力端子電極118に融着する。

【0018】また、最近では図14の導電性接着剤を用いた半導体ユニットの概略断面図に示されるように、半導体装置(IC基板)126の電極パッド123上にワイヤボンディング法またはメッキ法により電気的接続接点(Auバンプ)120を形成し、このAuバンプ120を導電性接着剤(接合層)125を介して回路基板129の入出力端子電極128に接続するような半導体ユニットも提案されている。このような半導体ユニットにおいては、半導体装置126のAuバンプ120に導電性接着剤125を転写してから、回路基板129の入出力端子電極128にAuバンプ120が当接するように位置合わせをし、導電性接着剤125を硬化して電気的接続を得ている。

【0019】

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来のキャピラリーおよび従来のバンプおよびバンプ形成方法は、半導体装置にバンプを形成する工程と、形成したバンプをさらに整形するためのレベリング工程とを要するためにコストがかかる。また、レベリングを行うための装置も別途必要である。しかし、レベリング工程を省くことは好ましくない。それは、ボールボンディング法によって形成されたバンプの頂部88は、リング状や逆U字型の形状をしているので、頂部88の端部の面積が小さいため、回路基板の端子電極との接触面積が小さい。また、バンプの高さのバラツキも大きいので、そのまま実装したのでは信頼性の高い接続を行うことはできない。さらに、導電性接着剤を接合層に用いる場合には、レベリング前のバンプの上記のような形状では、バンプ先端部への導電性接着剤の転写量が少なく、転写量のバラツキも大きいことから、導電性接着剤硬化した後の接着強度が小さいので接着の信頼性が低く接続抵抗値も大きくなってしまう。

【0020】回路基板上の端子電極はスクリーン印刷やメッキ法によって形成されているため、端子電極の断面

形状が凸状に湾曲している。そのため、半導体装置の凸状または平坦な先端面を設けたバンプを端子電極に接合層を介して接続すると、端子電極の湾曲面の頂点とバンプの先端部との間のみが電気的接続抵抗が一番小さくなる。よって、位置合わせ時にずれが生じた場合には、バンプと端子電極の距離が離れてしまい、接続抵抗値が増大する。また、接続部も不安定になる。

【0021】本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、半導体装置と回路基板とを、容易に、信頼性よく、電気的に安定に接続することを可能とするワイヤボンディング装置用のキャビラリ、それを用いた回路基板の端子電極と半導体チップの電極パッドとを電気的に接続するための湾曲面を有するバンプおよびバンプの形成方法およびそのバンプを有する半導体ユニット（実装体）を提供することにある。

【0022】

【課題を解決するための手段】本発明によるバンプの形成方法は、回路基板の表面の端子電極と、前記回路基板の表面上にフェイスタウト状態で実装される半導体装置の電極パッドとを電気的に接続するためのバンプを形成する方法であって、前記バンプを前記半導体装置の電極パッド上に形成する工程aと、前記バンプの先端部に湾曲面を形成する工程bとを含むことを特徴とする。

【0023】本発明による半導体ユニットは、表面に端子電極を有する回路基板と、前記回路基板の表面上にフェイスタウト状態で実装された半導体装置とを有する半導体ユニットであって、前記半導体装置は、電極パッドと、前記電極パッドと前記端子電極とを電気的に接続するためのバンプとを有し、前記バンプの先端部に湾曲面が形成され、前記バンプの先端部と前記端子電極との間に接合層が形成されていることを特徴とする。

【0024】

【作用】本発明は、バンプの先端部に凹型状の湾曲面を形成することによって、バンプの湾曲面が端子電極の曲面に面で接続するため、バンプと端子電極との接続距離が短縮されることになり、電気的導通が向上する。また、バルクが安定に形成されるため、接着強度が増強され、信頼性が極めて向上する。

【0025】

【実施例】以下に、本発明の各実施例を図面に基づき説明する。

【0026】（実施例1）図1（a）は本発明の第1の実施例におけるワイヤボンディング用のキャビラリーの先端部の概略断面図である。図1（b）は、キャビラリーの先端部の形状をより詳細に示している。

【0027】図1（a）に示されるように、円筒形のキャビラリー1は、その先端部の外周部に設けられた、レベリング部材である突出部3を有している。キャビラリー1は、セラミックあるいは人工ルビーにより作られて

いる。突出部3の下端面（レベリング面）15は、凸型状の湾曲面を持っており、キャビラリー1の先端のフェイス11からの高さが所定の値dであるように設けられている。下端面15の大きさは、ボンディングピッチおよび成形すべきバンプの先端径の大きさに応じて設定することができる。また、キャビラリー1の先端部の外側は、ボンディングする間隔とボンディング後の金属ワイヤ（あるいはバンプ）の形状および大きさとを考慮し、10～30°程度の角度αがつけられている。

10 【0028】図1（b）に示されるように、25μmの程度の金属ワイヤを用いる場合、キャビラリーの先端部の形状は、ホール径：38μm、チップ径：203μm、およびチャンファーリング径：74μmである。

【0029】図2は本発明の第1の実施例における半導体装置のバンプの正面図であり、これは半導体装置の一部における複数の電気的接続点のうちの1つを示している。図2に示すように、半導体装置（以下、IC基板という）6の上に突起電極（以下、バンプという）27が形成されている。このバンプ27の先端部には凹型状

20 の湾曲面24が設けられている。本実施例において、バンプ27は、図2に示されるように第1のバンプ27の上にそれより小さい第2のバンプ27'を有しており、2段になった突起状の形状をしている（以下、単にバンプ27という）。

【0030】図3（a）～（f）は本発明の第1の実施例におけるボルトボンディング法によって、ICチップ6の上に形成された電極パッド13の上に、キャビラリー1を用いて2段バンプを形成する方法の概略を示している。

30 【0031】図3（a）に示すように、キャビラリー1のワイヤ導出孔2に25μmの金属ワイヤ4を通す。そして、金属ワイヤ4の先端に、熱エネルギーを与えることにより、金属ワイヤ4の径の約2～3倍の径を有するボルト5を形成する。

【0032】次に、図3（b）に示すように、キャビラリー1を降下させることにより、金属ワイヤ4の先端に形成されたボルト5を、ICチップ6の電極パッド13に当接させる。熱圧着の方法や超音波振動を与えることによってボルト5を電極パッド13に固着させ、2段バンプの底部9を形成する。

40 【0033】そして、図3（c）に示すように、2段バンプの底部9と、キャビラリー1のワイヤ導出孔2に通された金属ワイヤ4とがつながった状態のまま、キャビラリー1をICチップ6に対してループ状に移動させる。キャビラリー1は、まず、2段バンプの底部9上方に垂直に上昇してからループ状軌道を描くように移動する。

【0034】図3（d）に示されるように、キャビラリー1がICチップ6に対してループ状に運動することにより、底部9の上には金属ワイヤ4がリング状または逆

U字状に形成される。

【0035】その後、キャビラリー1のエッジ部分12が2段バンプの底部9の外周に位置するようにキャビラリー1を移動させ、垂直に下降しながらエッジ部分12によって金属ワイヤ4を切断する。キャビラリー1はそのまま降下を続け、キャビラリー1の外周部に設けられた突出部分3の下端面15によって2段バンプを押圧整形する。このとき、キャビラリー1は、そのフェイス11が電極パッド13に当接するまで下降する(図3(e)参照)。

【0036】また、図3(f)に示されるように、正面から見たときにも湾曲面が形成されているようにキャビラリーの下端面15が作られていてもよく、湾曲面の形成される方向は問わない。

【0037】次に図4は本発明の第1の実施例における半導体装置を回路基板上に実装した半導体ユニットの一部断面図である。図4に示すように、上記の工程で得られた半導体装置(IC基板)6のバンプの先端部の湾曲面24に、接合層としての導電性接着剤25を転写法や印刷法によって塗布する。本実施例において、2段突起状のバンプを用いることにより、必要量以上の導電性接着剤25がバンプ先端部に付着するのを防ぎ、適量の導電性接着剤25を塗布することができる。しかし、バンプは、先端部に湾曲面24を有していれば、その形状は特に制限されるものではない。

【0038】このことによって、接合層の厚みを最も薄く均一なものとでき、接続部の接続抵抗が低く、信頼性の高い電気的接続と接着を実現できる。

【0039】(実施例2)図5(a)～(c)は本発明の第2の実施例における、ICチップ6の上の電極パッド13の上に形成されたバンプの先端部に、先端部に凸型状の湾曲面41をもつた治具を用いて凹型状の湾曲面24を形成する方法の概略を示している。

【0040】図5(a)はICチップ6の上の電極パッド13の上に形成された2段バンプである。このバンプの先端部を凸型状の湾曲面41をもつた治具を用いて押圧することによって、バンプの先端部に凹型状の湾曲面24を形成する。このとき、図5(b)、(c)に示すように、湾曲面の形成される方向は問わない。

【0041】この形成方法を用いても、図4に示す半導体ユニットが得られる。

(実施例3)図6は半田メッキバンプを用いた場合における本発明の第3の実施例におけるバンプの先端部に凹型状の湾曲面をもつ半導体装置の断面図(a)と、半導体装置を回路基板上に実装した半導体ユニットの一部断面図(b)である。

【0042】(実施例4)図7は1段突起状のバンプを用いた場合における本発明の第4の実施例におけるバンプの先端部に凹型状の湾曲面をもつ半導体装置の断面図(a)と、半導体装置を回路基板上に実装した半導体ユ

ニットの一部断面図(b)である。

【0043】(実施例5)図8は実施例1、2で得られた半導体装置を異方性導電材を界して回路基板上に実装した半導体ユニットの一部断面図である。

【0044】(実施例6)図9は実施例1、2で得られた半導体装置を、半導体装置と回路基板の間隙以上の厚みをもつた異方性導電材を界して回路基板上に実装した半導体ユニットの一部断面図である。

【0045】

10 【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、特殊なバンプの構造や製造方法に限られることなく、通常のボールボンディング法やメッキ法等を用いて形成されたバンプの先端部に、容易に湾曲面を形成することができるため、実用上において極めて汎用性が高い。

【0046】さらに、本発明により、半導体装置のバンプの先端部に湾曲面を形成することにより、バンプと回路基板上の端子電極との境界面間の接合距離を短縮し、電気的導通性を向上させることができる。これによって接着強度を増し、さらに、より確実で信頼性の高い電気的接続を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は本発明の第1の実施例におけるワイヤボンディング装置用のキャビラリーの先端部の概略断面図

(b)はキャビラリーの先端部の形状の詳細図

【図2】本発明の第1の実施例における半導体装置の2段突起状のバンプの正面図

【図3】本発明によるキャビラリーを用いて2段バンプを形成する方法の概略を示す工程図

【図4】本発明によって形成された2段バンプを有する半導体装置を、回路基板上に導電性接着剤によって実装された半導体ユニットを示す断面図

【図5】本発明の第2の実施例における、凸型状の治具を用いてバンプの先端部に凹型状の湾曲面を形成する方法の概略図

【図6】(a)および(b)は、本発明の第3の実施例におけるメッキバンプを有する半導体装置を、回路基板上に導電性接着剤によって接着する前の状態および実装された半導体ユニットを示す断面図

40 【図7】(a)および(b)は、本発明の第4の実施例における1段バンプを有する半導体装置を、回路基板上に導電性接着剤によって接着する前の状態および実装された半導体ユニットを示す断面図

【図8】本発明の第1、2の実施例における2段バンプを有する半導体装置を、回路基板上に異方性導電材によって実装した半導体ユニットを示す断面図

【図9】本発明の第1、2の実施例における2段バンプを有する半導体装置を、回路基板上に異方性導電材によって実装した図8と異なる半導体ユニットを示す断面図

9

【図10】(a)は従来のワイヤボンディング装置用のキャビラリーの先端部の概略断面図

(b)は従来のキャビラリーの先端部の形状の詳細図

【図11】従来のキャビラリーを用いたボールボンディング法によって2段バンプを形成する方法の概略を示す工程図

【図12】従来のボールボンディング法によってレベリングされたバンプの典型的な形状を示す概略断面図

【図13】(a)は従来の半導体装置の半田バンプの概略断面図

(b)は従来の半導体ユニットの概略断面図

【図14】従来の導電性接着剤を用いた半導体ユニットの概略断面図

【符号の説明】

- 1 キャビラリー
- 2 ワイヤ導出孔
- 3 突出部
- 4 金属ワイヤ
- 5 ポール
- 6 ICチップ(半導体装置)
- 7 バンプ
- 8 バンプの頂部
- 9 バンプの底部

10

11 キャビラリーのフェイス

12 キャビラリーのエッジ

13 電極パッド

15 突出部の下端面

24 バンプの先端部

25 導電性接着剤

27, 27' 突起電極(バンプ)

28 入出力端子電極

29 回路基板

41 凸型治具

42 凸型治具の突出部の下端面

60 電気的接続接点(半田バンプ)

61 金属膜

63 電極パッド

66 ICチップ(半導体装置)

68 入出力端子電極

69 回路基板

70 突起電極(バンプ)

73 電極パッド

20 76 ICチップ(半導体装置)

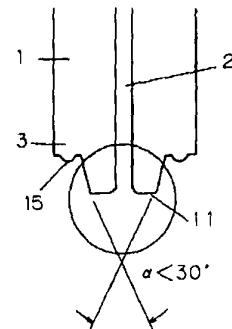
78 入出力端子電極

79 回路基板

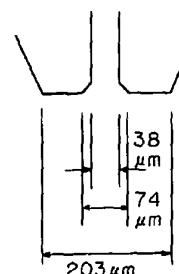
【図1】

(a)

- 1 キャビラリー
- 2 ワイヤ導出孔
- 3 突出部
- 11 キャビラリーのフェイス
- 15 突出部の下端面



(b)



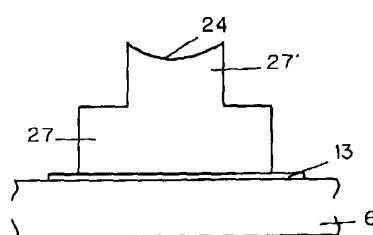
【図2】

6 ICチップ

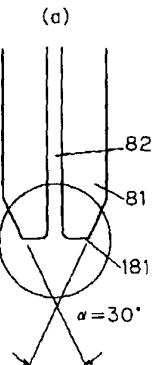
13 電極パッド

24 バンプの先端部

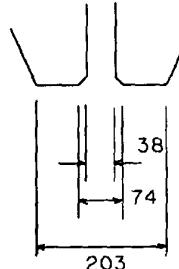
27, 27' 突起電極



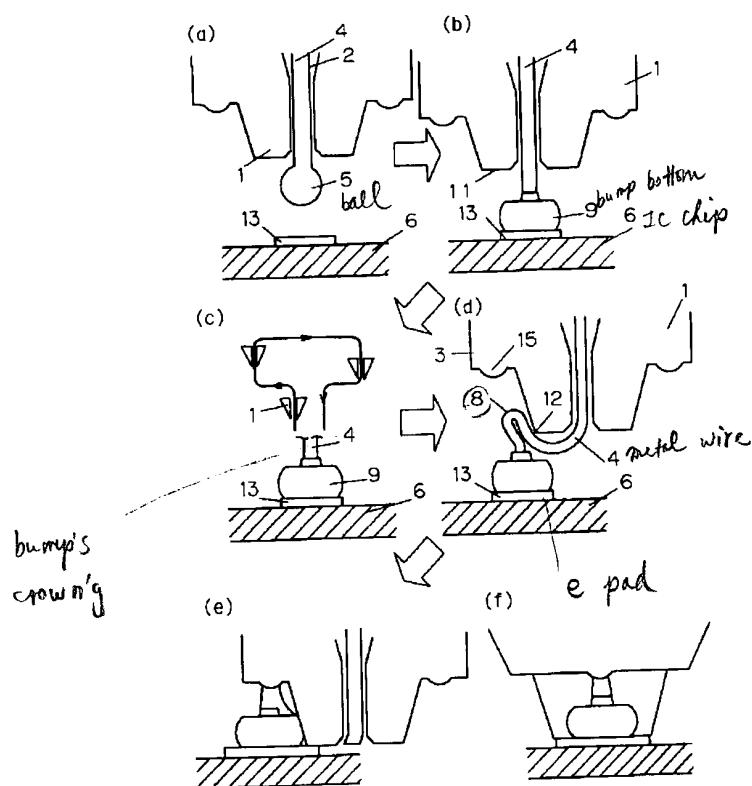
【図10】



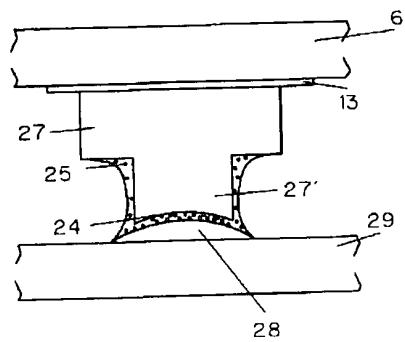
(b)



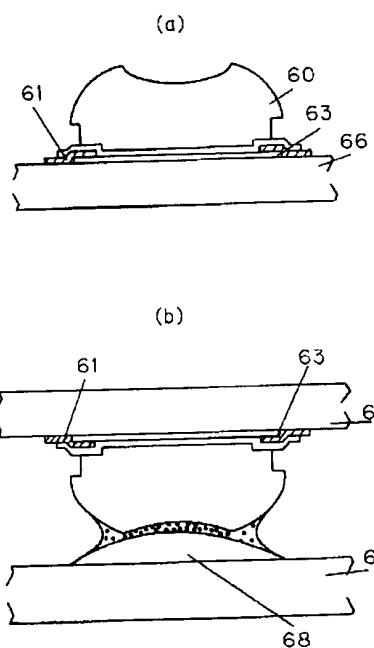
【図3】



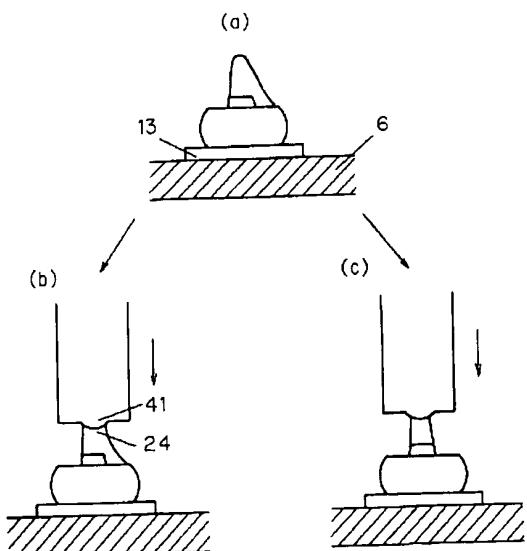
【図4】



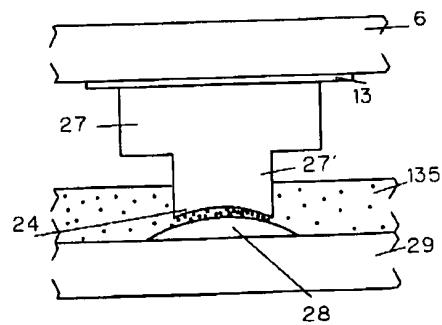
【図6】



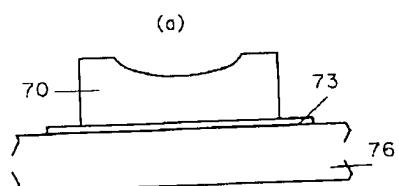
【図5】



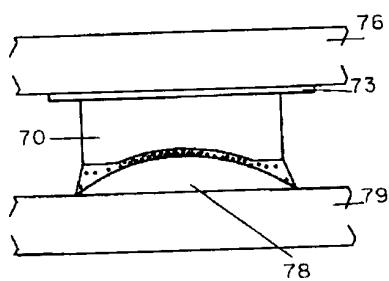
【図8】



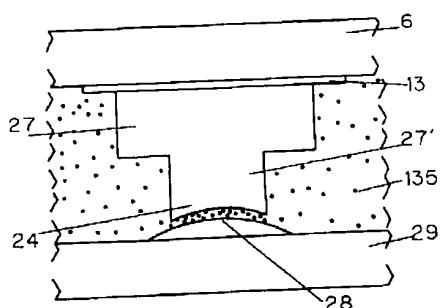
【図7】



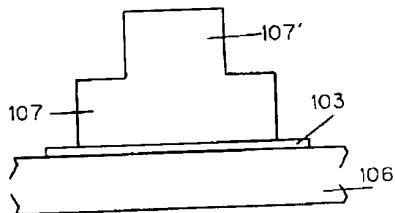
(b)



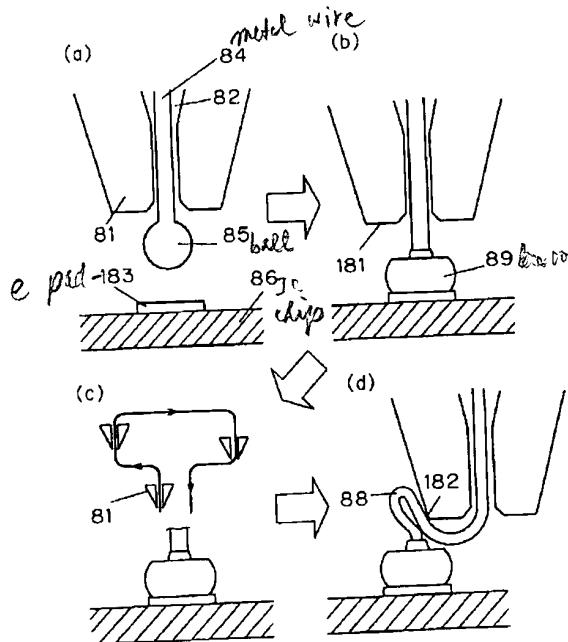
【図9】



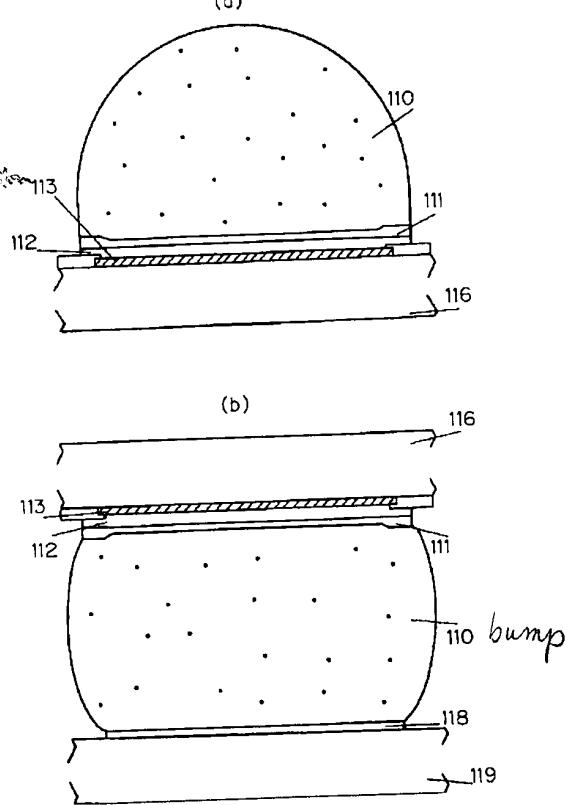
【図12】



【図11】



【図13】



【図14】

